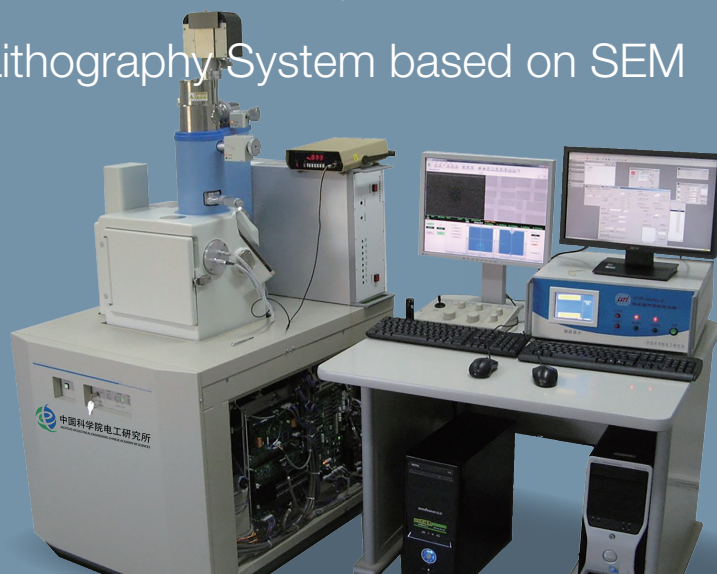


# 小型电子束曝光系统

Electron Beam Lithography System based on SEM

DY-2000A



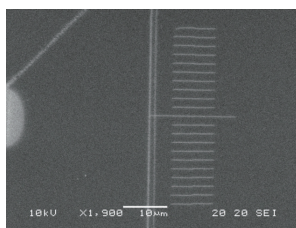
## 性能指标

- 加速电压: 1—30 kV
- 电子束直径: 6 nm
- 电子束流: 4 pA—10 nA
- 最细线宽: 20 nm
- 扫描速度: 5 MHz
- 图形尺寸精度: 0.06  $\mu\text{m}$ ;
- 场拼接精度: 0.1  $\mu\text{m}$
- 单场曝光范围: 10—1000  $\mu\text{m}$
- 位移台运动范围: 50 mm  $\times$  50 mm

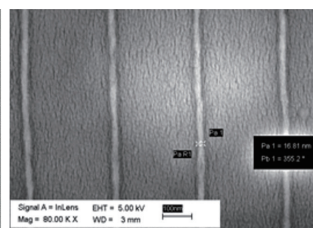
## 主要应用

微纳米器件制作、新型半导体器件研究

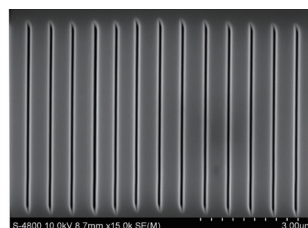
## 代表性应用成果



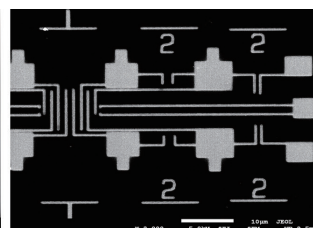
多场拼接游标图



16.8 nm 线图形



65 nm 等间距光栅



微耦合电路

主要用户单位	国家纳米科学中心、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、清华大学、南京大学
研制单位	中国科学院电工研究所
联系方式	刘俊标 010-82547185, 13693629614